



「高温動作集積回路開発の現状と課題」

◇ 日時: 2022年3月10日(木) 13:30~17:10

◇ 場所: Zoomによるオンライン開催

ワイドギャップ半導体の特徴の一つとして高温動作が挙げられ、この特徴を活かした高温動作集積回路の研究開発が進められている。高温動作集積回路実現にあたり、最適な材料やデバイス構造は定まっておらず、温度特性や信頼性などを考慮した包括的な検討が必要である。本討論会では、シリコン高温デバイスにおける知見を参照しつつ、幅広い分野の専門家にご講演頂き、参加者からも話題提供を頂きながら活発な議論を行う。

.....プログラム.....

開会のあいさつ 13:30~13:35

SOI-CMOS とリーク補償技術による高温用アナログ演算増幅回路の形成 13:35~14:05
高尾 英邦 (香川大学)

Si 系集積回路とパワーデバイスの高温動作における課題(仮) 14:05~14:35
永久 克己 (ルネサスエレクトロニクス)

原子スイッチを使った FPGA の開発とその高温動作 14:35~15:05
多田 宗弘 (ナノブリッジセミコンダクター)

休 憩 15:05~15:20

耐熱・放射線耐性の高い SiC-JFET の開発 15:20~15:50
田中 保宣 (産総研)

SiC MOSFET 集積回路の高温動作と SiC/金属界面信頼性 15:50~16:20
黒木 伸一郎 (広島大学)

休 憩 16:20~16:35

総合討論 16:35~17:10

閉会のあいさつ 17:10~17:15

■参加について: 本個別討論会は、従来の討論会とは異なりテーマに関係されていない方でも参加が可能です。討論会の性質上、参加者の方に意見や発言を求める場合がございますのでご理解ください。

■参加受付: WEB 参加受付システム ([ここ](#)をクリック*) から参加登録と決済をお願いします。締切 2月24日(木)

*本案内が印刷物の場合、下記よりアクセスして下さい。

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=5777077842503786&EventCode=P121780889

■参加費: (消費税込)

先進パワー半導体分科会会員* 2,000円、分科会学生会員 1,000円、一般 4,000円、一般学生 1,000円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いと致します。

■問合せ先:

金子 光顕 (京都大学)	TEL: 075-383-2302	e-mail: kaneko@semicon.kuee.kyoto-u.ac.jp
原田 俊太 (名古屋大学)	TEL: 052-789-3249	e-mail: shunta.harada@nagoya-u.ac.jp
出口 忠義 (日清紡マイクロデバイス)	TEL: 049-278-1441	e-mail: deguchi.tadayoshi@nisshinbo.co.jp
白石 陽子 (応用物理学会事務局)	TEL: 03-3828-7723	e-mail: shiraishi@jsap.or.jp